

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **11087670 A**

(43) Date of publication of application: **30.03.99**

(51) Int. Cl

**H01L 27/12**  
**G02F 1/136**  
**H01L 21/20**  
**H01L 21/268**  
**H01L 29/78**  
**H01L 29/786**  
**H01L 21/336**

(21) Application number: **09248751**

(22) Date of filing: **12.09.97**

(71) Applicant: **SANYO ELECTRIC CO LTD**

(72) Inventor: **SEGAWA YASUO**  
**YAMADA TSUTOMU**  
**YOKOYAMA RYOICHI**  
**YONEDA KIYOSHI**

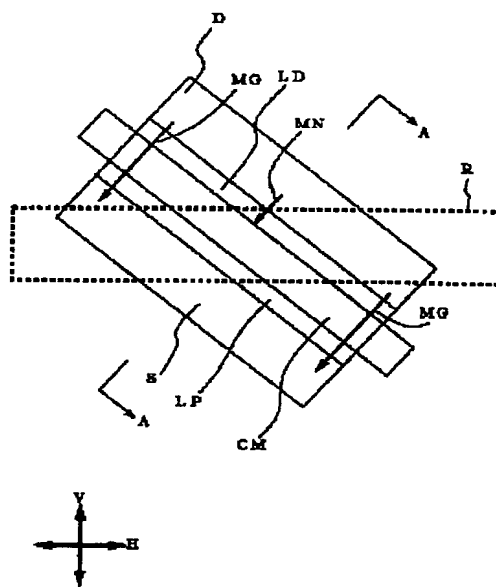
**(54) FABRICATION OF SEMICONDUCTOR DEVICE**

(57) Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To obtain good element characteristics by inclining the breadthwise direction of channel against the long axis direction of a region to be irradiated with a pulse laser thereby preventing fluctuation in the irradiating energy of pulse laser from having effect on the characteristics of a semiconductor element.

**SOLUTION:** Direction of a line beam is differentiated from a channel region for an element having channel width wider than the pitch of a pulse laser. Since a part of channel region deviates from a detective crystallization region R when it occurs to pass through the channel region, partial MG of moving path is held in good state. According to the arrangement, fluctuation in the irradiating energy of pulse laser has no effect on the characteristics of a semiconductor element and the characteristics thereof can be enhanced.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-87670

(43) 公開日 平成11年(1999)3月30日

(51) Int. Cl. <sup>6</sup>	識別記号	F I
H 0 1 L 27/12		H 0 1 L 27/12 R
G 0 2 F 1/136	5 0 0	G 0 2 F 1/136 5 0 0
H 0 1 L 21/20		H 0 1 L 21/20
21/268		21/268 F
29/78		29/78

審査請求 未請求 請求項の数5 O L (全 9 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平9-248751  
 (22) 出願日 平成9年(1997)9月12日

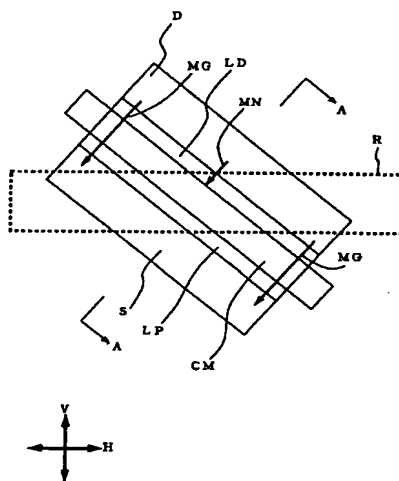
(71) 出願人 000001889  
 三洋電機株式会社  
 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号  
 (72) 発明者 瀬川 泰生  
 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋  
 電機株式会社内  
 (72) 発明者 山田 努  
 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋  
 電機株式会社内  
 (72) 発明者 横山 良一  
 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋  
 電機株式会社内  
 (74) 代理人 弁理士 安富 耕二 (外1名)  
 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 p-S i TFTLCDのp-S iを形成するレーザーアニールにおいて、照射領域の強度の不均一に起因したトランジスタ特性の悪化を防止する。

【解決手段】 チャンネル幅WがパルスレーザーのピッチPよりも大きな素子に関して、チャンネル領域CHを、そのチャンネル幅Wの方向がラインビームLBの長軸方向に対して傾けることにより、チャンネル領域CHに結晶化不良領域が生じて、素子特性に影響を及ぼすことがなくなり、良好なp-S i LCDの製造歩留まりが向上する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 パルスレーザーによるアニールが施された半導体膜をチャンネル領域に用いた半導体素子が複数形成された半導体装置の製造方法において、

前記パルスレーザーのピッチがPの時、前記チャンネル領域のチャンネル幅がPよりも大きい半導体素子に関して、前記チャンネル領域を、前記チャンネル幅方向が前記パルスレーザーの被照射領域の長軸方向及び短軸方向のいずれとも異なるようにしたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】 基板上に形成された多結晶半導体膜の島状層と、前記多結晶半導体膜の島状層中のチャンネル領域に絶縁膜を介して重畳配置されたゲート電極とを有し、前記多結晶半導体膜は、基板上に形成された非晶質半導体膜にパルスレーザーによるアニールを施すことにより多結晶化して得られる多結晶半導体素子を複数有した半導体装置の製造方法において、

前記パルスレーザーのピッチがPの時、前記チャンネル領域のチャンネル幅がPよりも大きい半導体素子に関して、前記チャンネル領域を、前記チャンネル幅方向が前記パルスレーザーの被照射領域の長軸方向及び短軸方向のいずれとも異なるようにしたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項3】 基板上に島状に形成された多結晶半導体膜が間に絶縁層を挟んでゲート電極に対向してなり、前記多結晶半導体膜中に、前記ゲート電極に対向するチャンネル領域と、このチャンネル領域の両側に間に不純物が低濃度に含有された低濃度領域を挟んで前記不純物が高濃度に含有されたソース領域及びドレイン領域を有し、前記多結晶半導体膜は、基板上に形成された非晶質半導体膜にパルスレーザーによるアニールを施すことにより多結晶化して得られる多数の多結晶半導体素子を有した半導体装置の製造方法において、

前記パルスレーザーのピッチがPの時、前記チャンネル領域のチャンネル幅がPよりも大きい半導体素子に関して、前記チャンネル領域を、前記チャンネル幅方向が前記パルスレーザーの被照射領域の長軸方向及び短軸方向のいずれとも異なるようにしたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項4】 前記基板の辺方向と前記パルスレーザーの被照射領域の長軸方向及び短軸方向とは略同一方向であり、前記チャンネル幅方向は、前記基板の辺方向と異なることを特徴とする請求項1から請求項3に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項5】 前記基板の辺方向と前記チャンネル幅方向とは略同一方向であり、前記パルスレーザーの被照射領域の長軸方向及び短軸方向は、前記基板の辺方向と異なることを特徴とする請求項1から請求項3に記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置、特に、液晶表示装置（LCD）、エレクトロルミネッセンス（EL）表示装置等、アクティブマトリクス型ディスプレイ装置に用いられる薄膜トランジスタ（TFT：thin film transistor）を、表示部におけるスイッチング素子として形成するとともに、周辺部に駆動回路を構成すべく形成した周辺駆動回路一体型ディスプレイの製造方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】光学部材として液晶や有機エレクトロルミネッセンス（EL）を用いた表示素子からなる平面ディスプレイ装置は、小型、薄型、低消費電力などの利点を有し、OA機器、AV機器等の分野で実用化が進められている。これらLCDや有機ELディスプレイ装置では、各表示素子の画像情報の保持と書き換えのタイミングを制御するスイッチング素子として、液晶やELを支持する基板上にTFTを作り込んだアクティブマトリクス型が、その画質の良さから主流となっている。中でも、TFTを表示素子のスイッチング素子としてのみならず、表示素子を駆動する周辺ドライバーを構成すべく表示素子群の周辺にも形成したドライバー内蔵型が開発され、更なる小型化や低コスト化が実現をしている。

【0003】ドライバー内蔵型の表示装置に用いるTFTとしては、ドライバーにも適用できる動作速度と、耐熱性の低い安価なガラス基板上に作成できる成膜温度の低さから、チャンネル層に多結晶半導体特にポリシリコン（p-Si）を用いたものが適している。ポリシリコンの形成に当たっては、基板上に形成されたアモルファスシリコンにレーザアニールを施すことにより、支持基板温度を400～600℃に抑えながら結晶化することができ、こうして得たp-Siを使ってTFTを形成するという方法により、無アルカリガラス基板上にドライバー回路を作成することが可能となる。

【0004】図8は、このようなレーザアニールを行うためのレーザアニール装置の構成図である。（51）はパルスレーザーを発生する発振源、（52）は、レンズ（55）、ミラー（56）からなる光学系、（53）は最終照射部、（54）は内部に被処理基板（59）を支持するステージ（58）を装備した処理チャンバである。レーザ発振源（51）において発生されたエキシマレーザ等のレーザ光は、光学系（52）に送出される。光学系（52）において、各種レンズ（55）はシリンダリカルレンズ、コンデンサレンズ等であり、ここを通過する間にレーザ光は所定の断面形状に整形されたレーザビームとされる。レーザビームは四角形、中でも、長軸方向が短軸方向に対して非常に大きなライン状とされる。このラインビームは、チャンバ（54）に設けられた透明な窓（60）を通して、チャンバ（54）内の被処理基板（59）に照射される。比処

理基板(59)を載せたステージ(58)は平面上を水平方向及び垂直方向に可動で、相対的に比処理基板(59)上をラインビームがスキャンされる。

【0005】図9は、被処理基板(59)の拡大断面図である。無アルカリガラス等の基板(10)上にTFTのゲート電極(11)と、これを覆うゲート絶縁膜(12)上に被処理膜である $a-Si(13a)$ が形成されている。図10は、得られた $p-Si(13)$ を用いたTFTの断面図である。図11はTFTの平面図であり、図9及び図10は図11のA-A線に沿った断面図となっている。 $a-Si(13A)$ にレーザーアニールを施すことにより得られた $p-Si(13)$ は、ゲート電極(11)の上方を通過する領域に島状に残され、ゲート電極(11)の直上領域をノンドープのチャンネル領域(CH)、その両側に不純物が低濃度にドーピングされたLD(Lightly Doped)領域(LD)、更にその外側に、不純物が高濃度にドーピングされたソース領域(S)及びドレイン領域(D)が形成されている。 $p-Si(13)$ 及びLD領域(LD)を形成する際にマスクとして用いられた注入ストップ膜(14)を覆って $SiNx$ 、 $SiO_2$ 等の層間絶縁膜(15)が形成されている。層間絶縁膜(15)上には、ソース電極(16)及びドレイン電極(17)が形成され、層間絶縁膜(15)中に形成されたコンタクトホール(CT)を介して各々ソース領域(S)及びドレイン領域(D)に接続されている。

【0006】従来、比処理基板(58)に形成される複数のTFTの向き即ちチャンネル領域(CH)のチャンネル幅の延長方向あるいはチャンネル長の延長方向は、基板平面に関して、水平方向(H)を向くか、垂直方向(V)を向いている。言い換えれば、各TFT素子間で、チャンネルの向きが互いに平行または直角をなす関係となっている。また、ラインビームの向き即ちラインビームの辺、及び、基板の辺等も、水平方向(H)あるいは垂直方向(V)を向いている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】図12は、 $a-Si(13A)$ への照射レーザーエネルギー(横軸)と、その時形成される $p-Si(13)$ のグレインサイズ(縦軸)との関係図である。エネルギーが大きくなるに従ってグレインサイズも大きくなるが、最大のグレインサイズが得られるあるエネルギー値 $E_0$ を越えるとグレインサイズが急激に小さくなる。従って、所定のグレインサイズを得るためには、エネルギーが $E_d$ と $E_u$ の狭い範囲内になければならない。

【0008】このため、ラインビームの照射エネルギーが僅かでもばらついて、最適範囲 $E_d \sim E_u$ 間から外れると、結晶化が十分に行われず、グレインサイズの小さい結晶化不良領域(R)が、 $p-Si$ 中のある領域に生じる。図11に、あるTFTのチャンネル領域(CH)と

結晶化不良領域(R)との位置関係を示す。チャンネル領域(CH)が、チャンネル幅Wがチャンネル長よりも長い細長形状であるとき、図に示されるように、基板上的あるTFTに関して、チャンネルの向き即ちチャンネル幅Wの延長方向と、結晶化不良領域(R)の向き即ち結晶化不良領域(R)の長軸の延長方向との関係は、平行であるか直角である。

【0009】図11において、チャンネル領域(CH)を結晶化不良領域(Rv)が縦断する場合は、チャンネル領域(CH)中の移動経路の一部が結晶化不良領域(Rv)により占められて悪化するに過ぎず(MN)、残りの移動経路(MG)は結晶化不良領域(Rv)を回避しているので、素子の正常な動作が可能となる。これに対して、結晶化不良領域(Rh)がチャンネル領域(CH)を横断する場合、結晶化不良領域(Rh)がチャンネル領域(CH)の一部でもかかっていると、全ての移動経路(MNh)が悪化し、この素子の特性は劣化する。

【0010】前述の如く、基板(58)に形成されるTFTの中いくつか、図11に示すような特性の悪化を被ると、これを含む装置全体が不良となる問題がある。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明はこの課題を解決するために成され、パルスレーザーによるアニールを施された半導体層をチャンネル領域に用いた半導体素子が複数形成された半導体装置の製造方法において、前記パルスレーザーのピッチがPの時、前記チャンネル領域のチャンネル幅がPよりも大きい半導体素子に関して、前記チャンネル領域を、前記チャンネル幅方向が前記パルスレーザーの被照射領域の長軸方向及び短軸方向のいずれとも異なるようにした構成である。

【0012】また、基板上に形成された多結晶半導体膜の島状層と、前記多結晶半導体膜の島状層中のチャンネル領域に絶縁膜を介して重畳配置されたゲート電極とを有し、前記多結晶半導体膜は、基板上に形成された非晶質半導体膜にパルスレーザーによるアニールを施すことにより多結晶化して得られる多結晶半導体素子を複数有した半導体装置の製造方法において、前記パルスレーザーのピッチがPの時、前記チャンネル領域のチャンネル幅がPよりも大きい半導体素子に関して、前記チャンネル領域を、前記チャンネル幅方向が前記パルスレーザーの被照射領域の長軸方向及び短軸方向のいずれとも異なるようにした構成である。

【0013】これにより、パルスレーザーのピッチと同じ幅を有する不良領域がチャンネル領域上に発生しても、チャンネル領域の全幅を占めることが少なくなり、素子特性の悪化が防がれる。更に、基板上に島状に形成された多結晶半導体膜が間に絶縁層を挟んでゲート電極に対向してなり、前記多結晶半導体膜中に、前記ゲート電極に対向するチャンネル領域と、このチャンネル領域

の両側に間に不純物が低濃度に含有された低濃度領域を挟んで前記不純物が高濃度に含有されたソース領域及びドレイン領域を有し、前記多結晶半導体膜は、基板上に形成された非晶質半導体膜にパルスレーザーによるアニール施すことにより多結晶化して得られる多数の多結晶半導体素子を有した半導体装置の製造方法において、前記パルスレーザーのピッチがPの時、前記チャンネル領域のチャンネル幅がPよりも大きい半導体素子に関して、前記チャンネル領域を、前記チャンネル幅方向が前記パルスレーザーの被照射領域の長軸方向及び短軸方向のいずれとも異なるようにした構成である。

【0014】これにより、パルスレーザーのピッチと同じ幅を有する不良領域がチャンネル領域上に発生しても、チャンネル領域の全幅を占めることが避けられ、良好な素子特性を有した半導体装置が製造される。

【0015】

【発明の実施の形態】図1及び図2を用いて、本発明の第1の実施の形態に係るレーザーアニール方法を示す。まず、図1は、大基板(1)に、表示装置に用いられるアクティブマトリクス基板(2)が複数枚例えば6枚含まれている。各アクティブマトリクス基板(2)において、(3)は表示素子がマトリクス状に配列形成される予定の表示部、(4)は各表示素子に表示信号を書き込むためにスイッチングを制御する走査信号を発生すべく形成される予定のゲートドライバー、(5)は走査信号に同期して各々の表示素子に表示信号を供給すべく形成される予定のドレインドライバーである。

【0016】これらアクティブマトリクス基板(2)は、各々の表示素子を構成すべく、対向電極を備えた対向基板と貼り合わされ、各アクティブマトリクス基板(2)毎に表示装置筐体が構成されて切り離され、個々の筐体内に光学部材である液晶が装填されて液晶表示装置(LCD)が完成される。表示部(3)において、各表示素子は、液晶を誘電層としたコンデンサと、このコンデンサに液晶を駆動するための表示信号電圧の書き換えと保持を制御するためのスイッチング素子としてのTFTが形成され、また、ドライバー部(4、5)においては、インバータを構成すべくCMOSトランジスタが、N-ch及びP-chのTFTにより形成される。

【0017】図1では、拡大断面を図9に示すような、基板(10)上にa-Si(13a)が形成された状態で、レーザーアニールを施す様子が示されている。パルスレーザーであるラインビーム(LB)の各ショットが、基板(1)上を所定のオーバーラップ量をもって順次にずらされていくことでスキャンが行われる。ラインビーム(LB)の長軸方向及び短軸方向は、各々基板(1)平面に関して水平方向(H)及び垂直方向(V)にされている。

【0018】図2は、レーザーアニールを用いて形成されたp-Si(13)を使って形成されるTFTの平面

図である。なお、図2のA-A線に沿う断面構造は図10と同じである。本発明では、後に詳述するように、チャンネル領域(CH)の向き即ちチャンネル幅W方向を、ラインビーム(LB)の向き即ち長軸方向、ここでは水平方向(H)から傾けている。これにより、電荷の移動経路の一部(MG)が結晶化不良領域(R)を回避して存在することができ、素子特性の悪化が防がれる。

【0019】まず、本願出願人は、結晶化不良領域(R)が発生する理由が以下の通りであることを突き止めた。初めに、図3に示すようにラインビーム(LB)のスキャンは、パルスレーザーの各ショット(STn)が、その短軸方向、ここでは垂直方向(V)に順次にずれていくことにより行われる。ここで、ラインビーム(LB)の線幅Tと線長は図8に示すレーザーアニール装置のレーザー発振源(51)と光学系(52)により設定される。即ち、パルスレーザーの各ショット間の安定性のために、発振源(51)の発振周波数は200~300Hz程度、例えば290Hzに設定され、ラインビーム(LB)の被照射領域におけるエネルギー密度の均一性のためにラインビーム(LB)の線幅Tは100~1000μm例えば600μmに設定される。更に、スキャン速度即ちステージ(58)のステージの移動速度によってスループットが決まると同時に、各ショット(STn)間のオーバーラップ量即ちピッチPが決定される。例えばP=30μmで、同一地点に関して20ショットの重ね撃ちに設定される。

【0020】パルスレーザーの照射エネルギーは、各ショット間で若干のばらつきが避けきれず、あるショットについて、照射エネルギーがEdとEuの間の非常に狭い最適範囲から外れてしまうと、結晶化が不良となり、そのショットは失敗となる。図3において、例えば、ショットSTn-3が失敗となった場合、続くショットSTn-2、STn-1、・・・が重ねられる領域は、再び結晶化が行われ、ショットSTn-3の失敗が回復されるが、ショットSTn-3の最後尾の帯状領域については、このショットが最終となるので、結晶化の不良が回復されず、結晶化不良領域(R)として残ってしまう。即ち、結晶化不良領域(R)は、ラインビーム(LB)のスキャン方向に垂直方向に延びる細長で、かつ、その線幅Tは、パルスレーザーのピッチPに等しいことが分かる。

【0021】Pは、前述の如く、装置及びプロセス条件によって決定されるが、チャンネル幅WがピッチPよりも大きい素子に関して、例えば、チャンネル領域(CH)の向きとラインビーム(LB)の向きとのなす角度θが、

【0022】

【数1】

$$W \sin \theta = P$$

【0023】の関係にあるとき、図4より、結晶化不良領域(R)がチャンネル領域(CH)上にある場合、結

晶化不良領域(R)が図のR1からR2の間に位置するときのみ、チャンネル領域(CH)中の移動経路(MN)が結晶化不良領域(R)を通過することを避けられず、この時、移動経路(MN)が全幅にわたって悪化し、素子特性が悪化する。即ち、結晶化不良領域(R)がこれ以外の領域を通過する場合は、素子特性が悪化することは防がれる。

【0024】このように、チャンネル領域(CH)とラインビーム(LB)の向きを異ならせることにより、たとえ結晶化不良領域(R)がチャンネル領域(CH)を通過するように発生しても、チャンネル領域(CH)の一部が、結晶化不良領域(R)から外れて、移動経路の一部が(MG)が良好に保たれ、良好な素子特性が得られる。

【0025】また、図5に示すように、チャンネル領域(CH)のチャンネル長がLの時、

【0026】

【数2】

$$W \sin \theta - L \cos \theta = P$$

【0027】の関係にある場合、結晶化不良領域(R)が図のR3に位置するときのみ、チャンネル領域(CH)中の移動経路(MN)が結晶化不良領域(R)を通過することが避けられず、移動経路(MN)が全幅にわたって悪化し、その素子が不良となる。即ち、結晶化不良領域(R)が、これ以外の領域を通過する場合は、移動経路の一部(MG)は悪化が防がれ、良好な素子特性が得られる。

【0028】更に、図6に示すように、LD領域(LD)の幅がL1の時、

【0029】

【数3】

$$W \sin \theta - (L + L1) \cos \theta = P$$

【0030】の関係にある場合、結晶化不良領域(R)が図のR4に位置するときのみ、チャンネル領域(CH)中のみならずLD領域(LD)をも合わせた領域における移動経路(MN)が、結晶化不良領域(R)をわたることを避けられず、従って、移動経路(MN)が全幅にわたって悪化し、その素子が不良となる。即ち、結晶化不良領域(R)がこれ以外の領域を通過する時、チャンネル領域(CH)及びLD領域(LD)をわたる移動経路の一部(MG)は悪化が防がれ、良好な素子特性が得られる。

【0031】なお、以上の説明において、水平方向(H)と垂直方向(V)とは、相互に置換可能であり、これらの方向が互いに直角な関係にあることが肝要である。また、ラインビーム(LB)の長軸方向と短軸方向、及び、大基板(1)の辺とアクティブマトリクス基板(2)の辺の方向は、水平方向(H)または垂直方向(V)である。

【0032】図7に、本発明の他の実施の形態に係るレ

ーザーアニール方法を示す。前述の実施の形態においては、大基板(1)即ちアクティブマトリクス基板(2)とラインビーム(LB)との関係を変えることなく、基板(1、2)上のチャンネル領域(CH)のチャンネル幅方向の向きを、基板(1、2)に対して傾けていた。本実施の形態では、基板(1、2)とチャンネル幅方向との関係を変えることなく、図7に示すように、基板(1、2)そのものを、ラインビーム(LB)に対して傾ける。

【0033】なお、本発明では、図7の関係をj得るために、基板(1、2)の向きを変えることによるか、ラインビーム(LB)の向きを変えるかは、区別するものではない。

【0034】

【発明の効果】以上の説明から明らかな如く、本発明で、レーザーアニールが施された半導体膜を用いて形成された半導体素子を複数有する半導体装置の製造方法に関し、チャンネル幅方向をパルスレーザーの被照射領域の長軸方向から傾けることにより、パルスレーザーの照射エネルギーのばらつきが半導体素子の特性へ影響を及ぼすことが防がれ、素子特性の良好な半導体装置の製造が可能となった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態にかかる被処理基板とラインビームの被照射領域との位置関係を示す平面図である。

【図2】本発明にかかるチャンネル領域と結晶化不良領域との位置関係を示す平面図である。

【図3】ラインビームがスキャンされる様子を示す平面図である。

【図4】本発明の実施の形態にかかるチャンネル領域と結晶化不良領域のラインビームの被照射領域との位置関係を示す平面図である。

【図5】本発明の実施の形態にかかるチャンネル領域と結晶化不良領域のラインビームの被照射領域との位置関係を示す平面図である。

【図6】本発明の実施の形態にかかるチャンネル領域と結晶化不良領域のラインビームの被照射領域との位置関係を示す平面図である。

【図7】本発明の他の実施の形態にかかる被処理基板とラインビームの被照射領域との位置関係を示す平面図である。

【図8】レーザーアニール装置の構成図である。

【図9】レーザーアニール時の被処理基板の断面図である。

【図10】TFTの断面図である。

【図11】TFTの平面図である。

【図12】レーザーエネルギーとグレインサイズの関係図である。

【符号の説明】

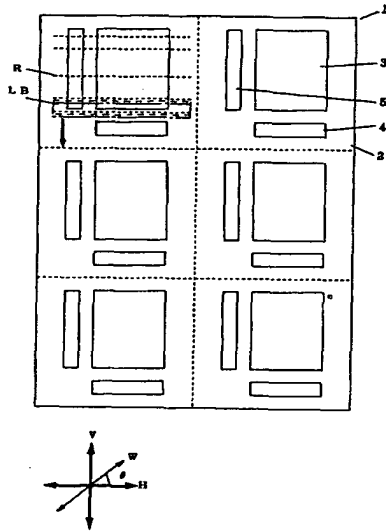
(6)

特開平11-87670

9

- 1 被処理基板
- 2 アクティブマトリクス基板
- 3 画素部
- 4 ゲートドライバー
- 5 ドレインドライバー
- 10 基板
- 11 ゲート電極
- 12 ゲート絶縁膜

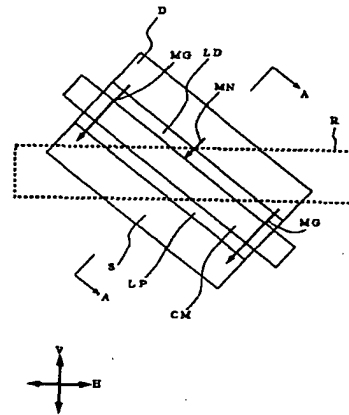
【図1】



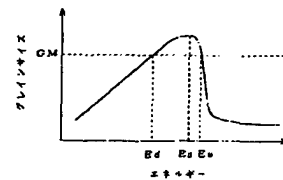
10

- 13 p-Si
- 16 ソース電極
- 17 ドレイン電極
- CH チャンネル領域
- D ドレイン領域
- S ソース領域
- LB ラインビームのエッジライン
- R 結晶化不良領域

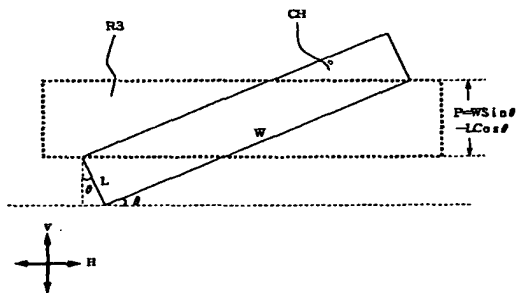
【図2】



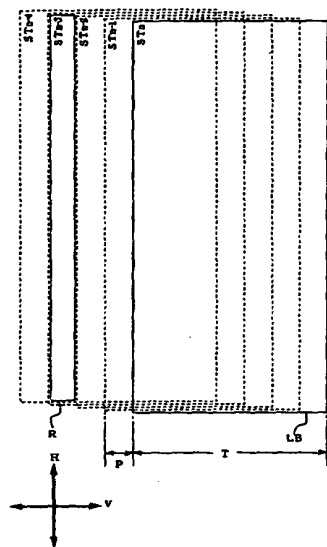
【図12】



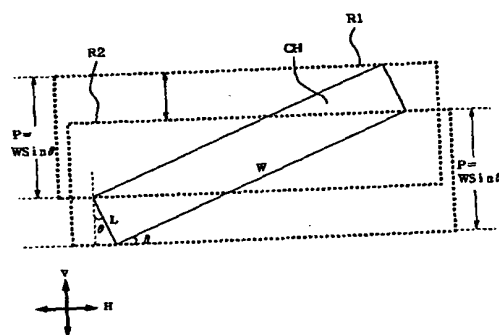
【図5】



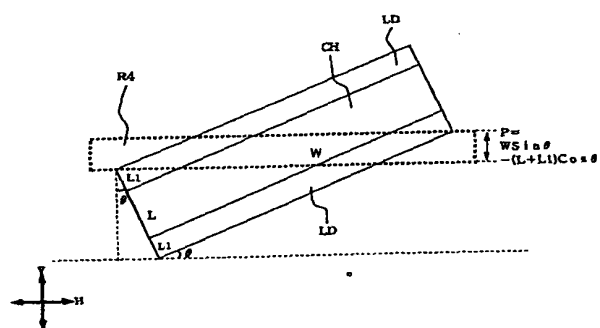
【図3】



【図4】

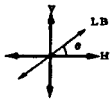
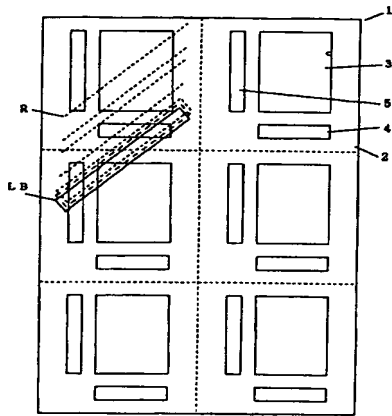


【図6】

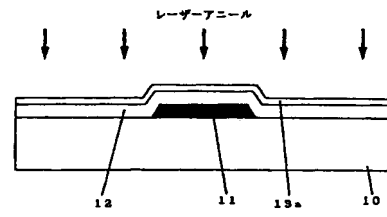




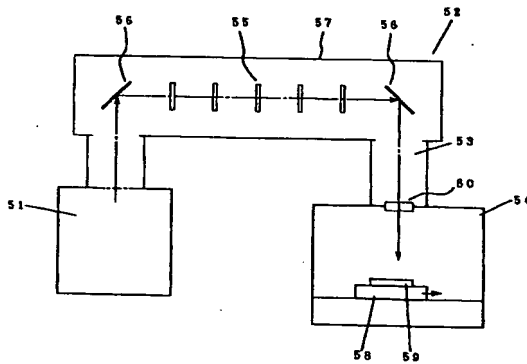
【図7】



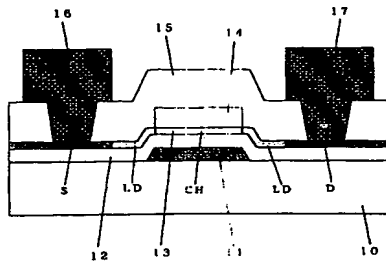
【図9】



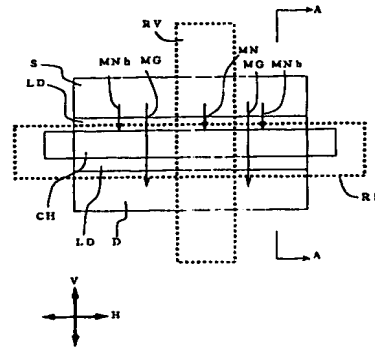
【図8】



【図10】



【図11】



フロントページの続き

(51)Int. Cl.<sup>6</sup>

H01L 29/786  
21/336

識別記号

FI

H01L 29/78

616A

618C

618A

627G

(72)発明者 米田 清

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三  
洋電機株式会社内